

PTO 2003-3612

Japanese Kokai Patent Publication No. H4-78173, published March 12, 1992;
Application No. H2-191743, filed July 19, 1990; Inventor: Kiyohiko MURANAKA;
Assignee: Nippon Denki KK (NEC Corporation)

SEMICONDUCTOR DEVICE WITH BUILT-IN EPROM

Claim

Semiconductor device with a built-in EPROM, characterized in that it is protected on at least the upper part of the gate electrode of an EPROM element by a polyimide film having a window.

Detailed Description of the Invention

The present invention concerns a semiconductor device with a built-in EPROM.

[Prior Art Technology]

As shown in Figure 2, with a conventional semiconductor device with a built-in EPROM, a silicon nitride film (8) or silicon oxynitride film was used as a final protective film (passivation film). The thickness of the silicon nitride film (8) is 0.3 – 0.5 μm .

[Problems the Invention is Meant to Resolve]

Due to the miniaturization of processes in recent years, the size of unevenness on the pellet surfaces of semiconductor devices has become great. For this reason, in places where there is great unevenness, there have been problems in that the passivation film has broken due to heat stress, or that in these places, when fine wiring parts were present, the wiring would slide, or the like.

As a countermeasure, flattening of the pellet surface is necessary, but flattening with a silicon nitride film or silicon oxynitride film, which are conventional materials, has been difficult.

[Means for Resolving Problems]

The semiconductor device with a built-in EPROM of the present invention is protected on at least the upper part of the gate electrode of an EPROM element by a polyimide film having a window.

[Embodiment]

The present invention is explained below with reference to the drawings. Figure 1 is a cross-sectional diagram of a semiconductor chip showing an embodiment of the present invention.

In the present embodiment, the passivation film is comprised of a silicon nitride film (9), having a thickness of $0.3\ \mu\text{m}$, which covers the semiconductor chip surface; and a polyimide film (10) (having a window [11] on the upper part of the gate electrode [floating gate electrode {3}]) with a thickness of $3 - 4\ \mu\text{m}$.

The silicon nitride film (9) prevents the polyimide film (10) from directly contacting the aluminum wiring (7).

The polyimide film has excellent flatness, but is non-transparent to ultraviolet light. However, because a window (11) is provided on the upper part of the floating gate electrode (3), writing in a wafer state and deleting after checking properties can be carried out.

It is not necessary for each EPROM element to be provided with a window (11); one may be provided for the entire EPROM part. In any case, after a polyimide film covers the entire surface, a window may be formed by selectively removing it using photolithography technology.

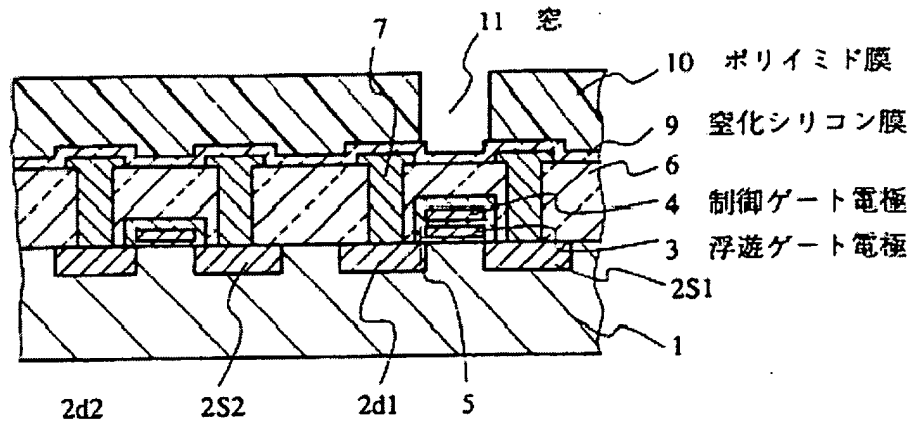
[Results of the Invention]

As has been explained above, with the present invention, because of the fact that a polyimide film is coated with the exception of the upper part of the gate electrode of the memory transistor (EPROM element), it is possible to relieve stress on the pellet surface due to heat stress, and the result is reliability can be improved for a semiconductor device with a built-in EPROM.

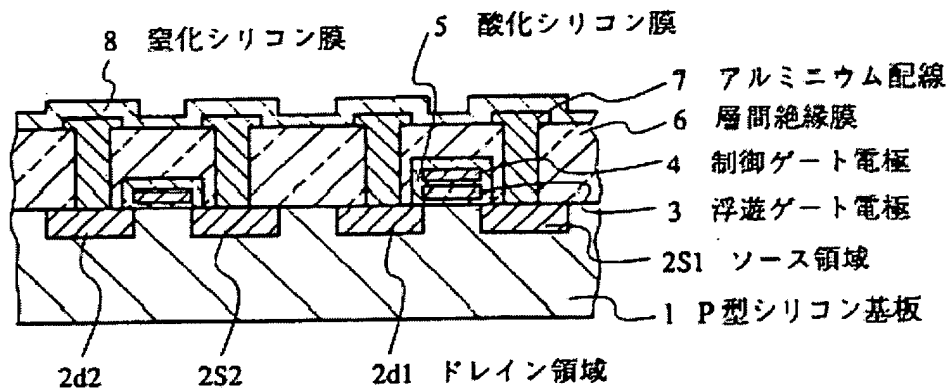
Simple Explanation of the Drawings

Figure 1 is a cross-sectional diagram showing an embodiment of the present invention, and Figure 2 is a cross-sectional diagram showing a conventional example.

1: p-type silicon substrate; 2d1, 2d2: drain regions; 2S1, 2S2: source regions; 3: floating gate electrode; 4: control gate electrode; 5: silicon oxide film; 6: interlayer insulation film; 7: aluminum wiring; 8, 9: silicon nitride films; 10: polyimide film; 11: window.



第 1 図



第 2 図

Translations Branch
 United States Patent and Trademark Office
 May 23, 2003
 Steven M. Spar

⑫ 公開特許公報(A) 平4-78173

⑤ Int. Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 平成4年(1992)3月12日

H 01 L 29/788
21/312
27/115
29/792

B 6940-4M

7514-4M H 01 L 29/78 3 7 1
8831-4M 27/10 4 3 4

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全2頁)

⑭ 発明の名称 E P R O M 内蔵型半導体装置

⑯ 特 願 平2-191743

⑰ 出 願 平2(1990)7月19日

⑱ 発 明 者 邑 中 清 彦 東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株式会社内

⑲ 出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目7番1号

⑳ 代 理 人 弁理士 内 原 晋

PTO 2003-3612

S.T.I.C. Translations Branch

明 細 書

発 明 の 名 称

E P R O M 内蔵型半導体装置

特 許 請 求 の 範 囲

E P R O M 素子の少なくともゲート電極上方に窓を有するポリイミド膜で保護されていることを特徴とするE P R O M 内蔵型半導体装置。

発 明 の 詳 細 な 説 明

〔産業上の利用分野〕

本発明はE P R O M 内蔵型半導体装置に関する。

〔従来の技術〕

従来のE P R O M 内蔵型半導体装置は第2図に示すように、最終保護膜(パッシベーション膜)は窒化シリコン膜8やオキシ窒化シリコン膜が用いられていた。窒化シリコン膜8の厚さは0.3~0.5μmである。

〔発明が解決しようとする課題〕

近年のプロセスの微細化により、半導体装置のベレット表面の凹凸は大きくなる一方である。この為凹凸の大きい場所では半導体装置が受ける熱ストレスにより、パッシベーション膜が割れたり、またこの場所が微細な配線の部分だったりすると配線がスライドするなどの問題があった。

この対策にはベレット表面の平坦化が必要であるが、従来のパッシベーション材料である窒化シリコン膜やオキシ窒化シリコン膜では平坦化を行うのが困難であった。

〔課題を解決するための手段〕

本発明のE P R O M 内蔵型半導体装置は、E P R O M 素子の少なくともゲート電極上方に窓を有するポリイミド膜で保護されているというものである。

〔実施例〕

次に本発明について図面を参照して説明する。第1図は本発明の一実施例を示す半導体チップの断面図である。

この実施例において、パッシベーション膜は、半導体チップ表面を覆う厚さ0.3 μ mの窒化シリコン膜9と、厚さ3～4 μ mのポリイミド膜10 (EPR OM素子のゲート電極(浮遊ゲート電極3)の上方に窓11を有している)とからなっている。

窒化シリコン膜9はポリイミド膜10とアルミニウム配線7とが直接接触れるのを防止している。

ポリイミド膜は平坦性に優れているが、紫外線に対し不透明である。しかし、浮遊ゲート電極3上方に窓11が設けられているので、ウェーハ状態で書き込み、特性チェック後に消去作業を行うことが可能となる。

窓11はEPR OM素子ごとに設ける必要はなく、EPR OM部全体に一つ設けてもよい。いずれにせよ、ポリイミド膜を全面に被着したのちフォトリソグラフィ技術により選択的に除去して窓を形成すればよい。

〔発明の効果〕

以上説明したように本発明は、メモリートラン

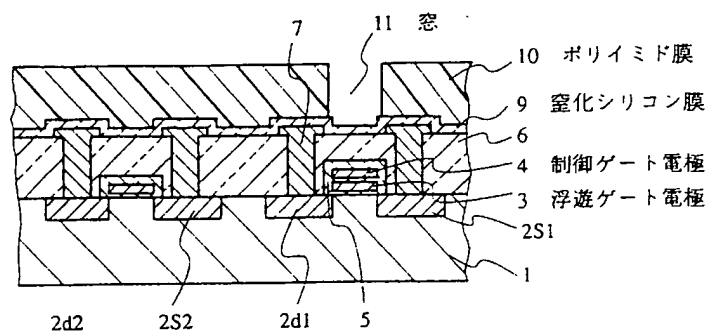
ジスタ(EPR OM素子)のゲート電極上部を除きポリイミド膜を被着してパッシベーション膜とすることにより、熱ストレスによるベレット表面への応力を緩和することが出来、EPR OM内蔵型半導体装置の信頼性を改善できる効果がある。

図面の簡単な説明

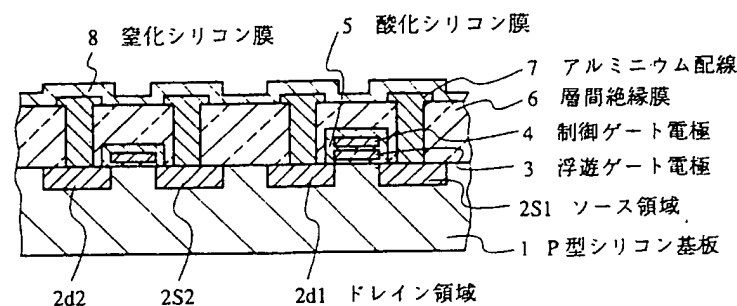
第1図は本発明の一実施例を示す断面図、第2図は従来例を示す断面図である。

1…P型シリコン基板、2d1、2d2…ドレイン領域、2S1、2S2…ソース領域、3…浮遊ゲート電極、4…制御ゲート電極、5…酸化シリコン膜、6…層間絶縁膜、7…アルミニウム配線、8、9…窒化シリコン膜、10…ポリイミド膜、11…窓。

代理人 弁理士 内 原 晋



第1図



第2図